

2SA606, 607/2SC959, 960

PNP/NPN エピタキシアル形シリコントランジスタ

PNP/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用 / Audio Frequency Amplifier

特 徵/FEATURES

- ・実効出力30~50Wのステレオアンプのドライバとして最適。
Suitable for Driver of 30 to 50 watts Audio Amplifiers.
- ・電流増幅率の電流に対するリニアリティがよい。
Excellent Current gain linearity.

绝对最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25℃)

項 目	略 号	2SA606	2SA607	2SC559	2SC960	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-100	-100	120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	-80	80	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	-5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-0.7	-0.7	0.7	0.7	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}^*$	-1.2	-1.2	1.2	1.2	A
全損失	$P_T(T_C=25^{\circ}C)$	0.7	1.0	0.7	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150				$^{\circ}C$
保存温度	T_{stg}	-65~+150				$^{\circ}C$

* PW $\leq$ 10ms, duty cycle $\leq$ 50%電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a = 25℃)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=80V, I_E=0$			3.0	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.5V, I_C=0$			3.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA^*$	20			
	h_{FE2}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=200mA^*$	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA^*$			2.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=100mA$	50			MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$			50	pF

* パルス測定 PW $\leq 350\mu\text{s}$ duty cycle $\leq 2\%$ /pulsedh_{FE} 区分/h_{FE} classification
$$h_{\text{reg}}/N : 40 \sim 80 \quad M : 60 \sim 110 \quad L : 90 \sim 150 \quad K : 130 \sim 200$$

外形圖/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

